



(11)

**EP 3 238 269 B8**

(12) **FASCICULE DE BREVET EUROPEEN CORRIGE**

(15) Information de correction:

**Version corrigée no 1 (W1 B1)**  
**Corrections, voir**  
**Bibliographie code(s) INID 73**

(51) Int Cl.:

**H01L 29/778** <sup>(2006.01)</sup> **H01L 29/861** <sup>(2006.01)</sup>  
**H01L 29/06** <sup>(2006.01)</sup> **H01L 29/20** <sup>(2006.01)</sup>

(48) Corrigendum publié le:

**20.01.2021 Bulletin 2021/03**

(86) Numéro de dépôt international:

**PCT/IB2015/059623**

(45) Date de publication et mention  
de la délivrance du brevet:

**12.08.2020 Bulletin 2020/33**

(87) Numéro de publication internationale:

**WO 2016/103111 (30.06.2016 Gazette 2016/26)**

(21) Numéro de dépôt: **15820282.0**

(22) Date de dépôt: **15.12.2015**

(54) **DISPOSITIF DE MODULATION COMPORTANT UNE NANO-DIODE**

MODULATIONSVORRICHTUNG MIT EINER NANODIODE

MODULATION DEVICE COMPRISING A NANODIODE

(84) Etats contractants désignés:

**AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB**  
**GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO**  
**PL PT RO RS SE SI SK SM TR**

(74) Mandataire: **Gevers & Orès**

**Immeuble le Palatin 2**  
**3 Cours du Triangle**  
**CS 80165**  
**92939 Paris La Défense Cedex (FR)**

(30) Priorité: **22.12.2014 FR 1463140**

(43) Date de publication de la demande:  
**01.11.2017 Bulletin 2017/44**

(56) Documents cités:

**WO-A1-2014/134490 WO-A2-02/086973**  
**WO-A2-2007/072405**

(73) Titulaires:

- **Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.)**  
**75016 Paris (FR)**
- **Université de Lille**  
**59800 Lille (FR)**

- **SONG A M ET AL: "Unidirectional electron flow in a nanometer-scale semiconductor channel: A self-switching device", APPLIED PHYSICS LETTERS, AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS, 2 HUNTINGTON QUADRANGLE, MELVILLE, NY 11747, vol. 83, no. 9, 1 septembre 2003 (2003-09-01), pages 1881-1883, XP012035982, ISSN: 0003-6951, DOI: 10.1063/1.1606881**
- **SANGARE PAUL ET AL: "Zero-bias GaN implanted Self-Switching Diode coupled with bow-tie antenna for THz applications", 2014 44TH EUROPEAN MICROWAVE CONFERENCE, EUROPEAN MICROWAVE ASSOCIATION, 6 octobre 2014 (2014-10-06), pages 806-809, XP032706806, DOI: 10.1109/EUMC.2014.6986557**

(72) Inventeurs:

- **GAQUIERE, Christophe Pierre Paul**  
**59650 Villeneuve d'Ascq (FR)**
- **DUCOURNAU, Guillaume**  
**59310 Orchies (FR)**
- **FAUCHER, Marc**  
**59810 Lesquin (FR)**

Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets, toute personne peut faire opposition à ce brevet auprès de l'Office européen des brevets, conformément au règlement d'exécution. L'opposition n'est réputée formée qu'après le paiement de la taxe d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen).

**EP 3 238 269 B8**

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• MATEOS J ET AL: "Noise and Terahertz rectification in semiconductor diodes and transistors", NOISE AND FLUCTUATIONS (ICNF), 2011 21ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON, IEEE, 12 juin 2011 (2011-06-12), pages 16-21, XP032038873, DOI: 10.1109/ICNF.2011.5994291 ISBN: 978-1-4577-0189-4</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• SÁNCHEZ-MARTÍN H ET AL: "Voltage controlled sub-THz detection with gated planar asymmetric nanochannels", APPLIED PHYSICS LETTERS, AIP PUBLISHING LLC, US, vol. 113, no. 4, 043504, 25 July 2018 (2018-07-25), pages 1-4, XP012230270, ISSN: 0003-6951, DOI: 10.1063/1.5041507 [retrieved on 2018-07-25]</li></ul> |
|--|--|